







	<h2>SIR424DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR424DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 30A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SIR424DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 18849 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIR424DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 30A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	18849 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 30A (Tc) 4.8W (Ta), 41.7W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	4.8W (Ta), 41.7W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.5 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1250pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIR424DP-T1-GE3CT

SIR424DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIR424DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIR424DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIR424DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIR426DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR428DP VISHAY SIR428DP VISHAY</p>	 <p>SIR422DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 40V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR424DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 30A PPAK SO-8</p>
 <p>SIR422DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR428DP-T1-GE3 VISHAY SIR428DP-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SIR422DP-T1-E3 VISHAY SIR422DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIR426DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 40V 30A PPAK SO-8</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ SIR406DP-T1-GE3	➔ SIR406DP-T1-GE3	➔ SIR406DP-T1-GE3-S	D SIR408DP-T1-GE3	➔ SIR408DP-T1-GE3
➔ SiR410DP-T1-E3	⚙ SIR410DP-T1-GE3	D SIR410DP-T1-GE3	➔ SiR412DP	➔ SiR412DP-T1-E3
⚙ SIR412DP-T1-GE3	➔ SIR412DP-T1-GE3	⚙ SIR414DP	➔ SIR414DP-T1-GE3	➔ SIR414DP-T1-GE3
D SIR416DP	⚙ SiR416DP-T1-E3	➔ SIR416DP-T1-GE3	⚙ SIR416DP-T1-GE3	➔ SiR418DP-T1-E3
➔ SIR418DP-T1-GE3	➔ SIR418DP-T1-GE3	⚙ SiR422DP-T1-E3	➔ SIR422DP-T1-GE3	➔ SIR422DP-T1-GE3
➔ SIR424DP-T1-GE3	➔ SIR426DP-T1-GE3	D SIR426DP-T1-GE3	⚙ SIR428DP	➔ SIR428DP-T1-E3
⚙ SIR428DP-T1-GE3	D SIR432DP-T1-GE3	➔ SIR432DP-T1-GE3	➔ SiR436DP-T1-E3	➔ SIR436DP-T1-GE3
➔ SIR436DP-T1-GE3	⚙ SiR438DP	➔ SIR438DP-T1-GE3	➔ SIR438DP-T1-GE3	➔ SIR440DP-T1-GE3
⚙ SIR440DP-T1-GE3	➔ SIR460DP	⚙ SIR460DP-T1-E3	D SIR460DP-T1-GE3	➔ SIR460DP-T1-GE3
➔ SIR462DP	⚙ SIR462DP-T1-E3	➔ SIR462DP-T1-GE3	⚙ SIR462DP-T1-GE3	➔ SIR464DP-T1

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited